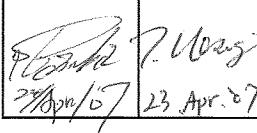
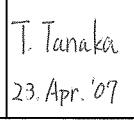


PAH450S48-*

RELIABILITY DATA

信頼性データ

DWG.NO. C247-57-01		
承認	査閲	担当
 23 Apr. '07	 23 Apr. '07	T. Tanaka 23 Apr. '07

INDEX

	PAGE
1 . MTBF計算値 Calculated Values of MTBF	R-1
2 . 部品ディレーティング Component Derating	R-2
3 . 主要部品温度上昇値 Main Components Temperature Rise ΔT List	R-4
4 . アブノーマル試験 Abnormal Test	R-5
5 . 振動試験 Vibration Test	R-8
6 . ノイズシミュレート試験 Noise Simulate Test	R-9
7 . はんだ耐熱性試験 Resistance to Soldering Heat Test	R-11
8 . 热衝撃試験 Thermal Shock Test	R-12
9 . 高温貯蔵試験 High Temperature Storage Test	R-14
10 . 低温貯蔵試験 Low Temperature Storage Test	R-15
11 . 高温加湿通電試験 High Temperature and High Humidity Bias Test	R-16
12 . 高温連続通電試験 High Temperature Bias Test	R-17

※ 信頼性試験は、代表データであり、全ての製品は、ほぼ同等な特性を示します。
 従いまして、この値は実力値とお考え願います。
 The following data are typical values. As all units have nearly the same
 characteristics, the data to be considered as ability values.

1. MTBF計算値 Calculated Values of MTBF

MODEL : PAH450S48- *

(1) 算出方法 Calculating Method

Telcordiaの部品ストレス解析法(*1)で算出されています。

故障率 λ_{SS} は、それぞれの部品ごとに電気ストレスと動作温度によって決定されます。

Calculated based on parts stress reliability projection of Telcordia (*1).

Individual failure rate λ_{SS} is calculated by the electric stress and temperature rise of the each device.

*1: Telcordia (Bellcore) "Reliability Prediction Procedure for Electronic Equipment"
(Document number TR-332, Issue5)

<算出式>

$$MTBF = \frac{1}{\lambda_{equip}} = \frac{1}{\pi_E \sum_{i=1}^m N_i \cdot \lambda_{ssi}} \times 10^9 \text{ 時間 (hours)}$$

$$\lambda_{ssi} = \lambda_{Gi} \cdot \pi_{Qi} \cdot \pi_{Si} \cdot \pi_{Ti}$$

λ_{equip} : 全機器故障率 (FITs) Total Equipment failure rate (FITs = Failures in 10^9 hours)

λ_{Gi} : i 番目の部品に対する基礎故障率 Generic failure rate for the i th device

π_{Qi} : i 番目の部品に対する品質ファクタ Quality factor for the i th device

π_{Si} : i 番目の部品に対するストレスファクタ Stress factor for the i th device

π_{Ti} : i 番目の部品に対する温度ファクタ Temperature factor for the i th device

m : 異なる部品の数 Number of different device types

N_i : i 番目の部品の個数 Quantity of i th device type

π_E : 機器の環境ファクタ Equipment environmental factor

(2) MTBF値 MTBF Values

条件 Conditions : Vin = 48VDC

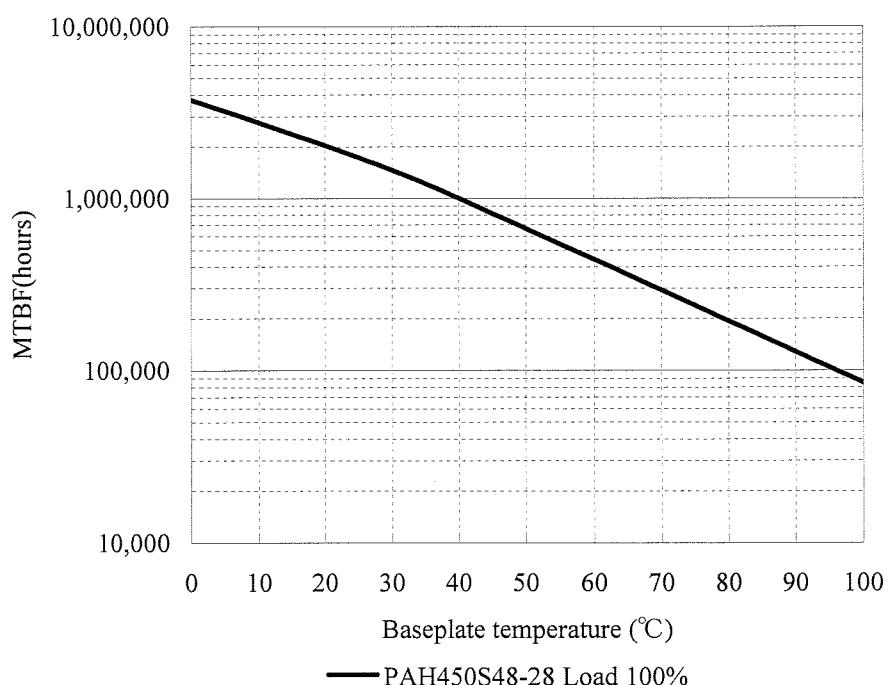
Environment GB (Ground, Benign)

PAH450S48-28

Output Current: 16A (100%)

Baseplate temperature vs. MTBF

Baseplate temperature	MTBF
25°C	1,733,846 (hours)
40°C	1,004,186 (hours)
80°C	194,027 (hours)
100°C	84,964 (hours)



2. 部品ディレーティング Component Derating

MODEL : PAH450S48-28

(1) 算出方法 Calculating Method

(a) 測定条件 Measuring Conditions

・入力電圧 Input Voltage	: 48VDC
・出力電流 Output Current	: 16A (100%)
・取付方法 Mounting Method	: 標準取付 (放熱器有) Standard Mounting Method (with Heatsink)
・ベースプレート温度 Baseplate Temperature	: 100°C

(b) 半導体 Semiconductors

ケース温度、消費電力および熱抵抗より使用状態の接合点温度を求め、最大定格との比較を行いました。

The maximum rating temperature is compared with junction temperature which is calculated based on case temperature, power dissipation and thermal impedance.

(c) IC、抵抗、コンデンサー等 IC, Resistors, Capacitors, etc.

周囲温度、使用状態、消費電力など、個々の値は設計基準内に入っています。

Ambient temperature, operating condition, power dissipation, etc are within derating criteria.

(d) 热抵抗算出方法 Calculating Method of Thermal Impedance

$$\theta_{j-l} = \frac{T_{j(max)} - T_l}{P_{c(max)}} \quad \theta_{j-c} = \frac{T_{j(max)} - T_c}{P_{c(max)}} \quad \theta_{j-a} = \frac{T_{j(max)} - T_a}{P_{c(max)}}$$

T_c : ディレーティングの始まるケース温度 一般に25°C
Case Temperature at Start Point of Derating ; 25°C in General

T_a : ディレーティングの始まる周囲温度 一般に25°C
Ambient Temperature at Start Point of Derating ; 25°C in General

T_l : ディレーティングの始まるリード温度 一般に25°C
Lead Temperature at Start Point of Derating ; 25°C in General

P_{c(max)} : 最大コレクタ(チャネル)損失
(P_{ch(max)}) Maximum Collector(Channel) Dissipation

T_{j(max)} : 最大接合点温度
(T_{ch(max)}) Maximum Junction(Channel) Temperature

θ_{j-c} : 接合点からケースまでの熱抵抗
(θ_{ch-c}) Thermal Impedance between Junction(Channel) and Case

θ_{j-a} : 接合点から周囲までの熱抵抗
(θ_{ch-a}) Thermal Impedance between Junction(Channel) and Air

θ_{j-l} : 接合点からリードまでの熱抵抗
(θ_{ch-l}) Thermal Impedance between Junction(Channel) and Lead

(2) 部品ディレーティング表 Component Derating List

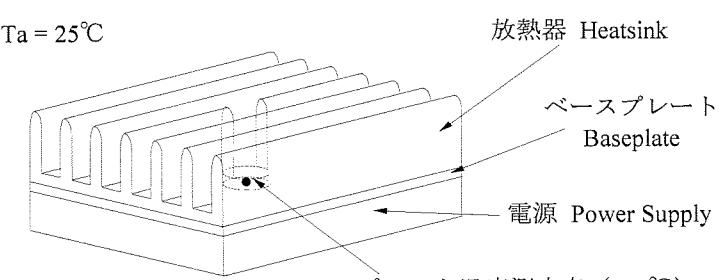
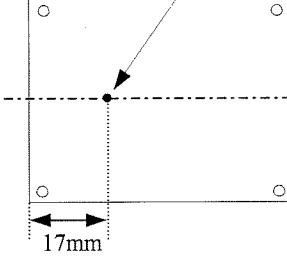
部品番号 Location No.	部品名 Part Name	最大定格 MAX Rating	使用状態 Actual Rating	ディレーティング率 Derating Factor
Q1	CHIP TRANSISTOR	T _j (max): 150.0°C	T _j : 133.0°C	88.7%
Q2	CHIP TRANSISTOR	T _j (max): 150.0°C	T _j : 136.7°C	91.2%
Q19	CHIP MOS FET	T _{ch} (max): 150.0°C	T _{ch} : 125.8°C	83.9%
Q101	CHIP MOS FET	T _{ch} (max): 150.0°C	T _{ch} : 123.2°C	82.2%
Q102	CHIP MOS FET	T _{ch} (max): 150.0°C	T _{ch} : 122.2°C	81.5%
Q103	CHIP MOS FET	T _{ch} (max): 150.0°C	T _{ch} : 127.0°C	84.7%
Q104	CHIP MOS FET	T _{ch} (max): 150.0°C	T _{ch} : 132.6°C	88.4%
Q105	CHIP MOS FET	T _{ch} (max): 150.0°C	T _{ch} : 129.2°C	86.2%
Q202	CHIP TRANSISTOR	T _j (max): 150.0°C	T _j : 112.5°C	75.0%
D104	CHIP SBD	T _j (max): 150.0°C	T _j : 109.6°C	73.1%
D106	CHIP SBD	T _j (max): 150.0°C	T _j : 110.2°C	73.5%
A4	PWM IC	T _j (max): 150.0°C	T _j : 120.9°C	80.6%
A5	PWM IC	T _j (max): 150.0°C	T _j : 115.4°C	76.9%

3. 主要部品温度上昇値 Main Components Temperature Rise ΔT List

MODEL : PAH450S48-28

部品番号 Location No.	部品名 Part Name	温度上昇値 ΔT_{C-P} Temperature Rise (°C)
Q1	CHIP TRANSISTOR	23.5
Q2	CHIP TRANSISTOR	21.5
Q19	CHIP MOS FET	22.0
Q101	CHIP MOS FET	7.0
Q102	CHIP MOS FET	6.0
Q103	CHIP MOS FET	13.4
Q104	CHIP MOS FET	19.5
Q105	CHIP MOS FET	16.1
Q202	CHIP TRANSISTOR	10.3
D104	CHIP SBD	4.1
D105	CHIP SBD	4.7
A4	PWM IC	20.9
A5	PWM IC	8.8
	BASEPLATE	0 (basis)

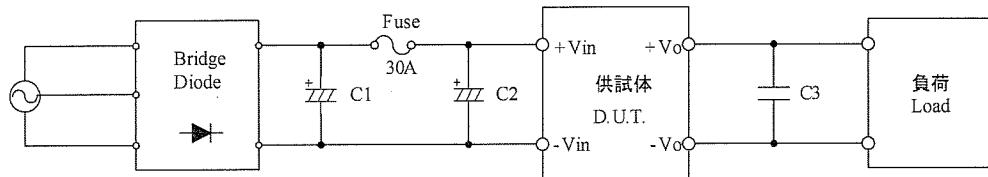
・ 測定条件 Measuring Conditions

取付方法 Mounting Method	標準取付 (放熱器有) Standard Mounting Method (with Heatsink)	
	T _a = 25°C	ベースプレート 温度測定点 (100°C) Measuring point of Baseplate Temperature
		
		
入力電圧 Input Voltage	48VDC	
出力電圧 Output Voltage	28VDC	
出力電流 Output Current	16A (100%)	

4. アブノーマル試験 Abnormal Test

MODEL : PAH450S48-28

(1) 試験条件及び回路 Test Condition and Circuit



- | | | | |
|-------------------------------------|--------------|------------------------------------|----------------------|
| ・入力電圧
Input Voltage | : 76VDC | ・出力電流
Output Current | : 16A(100%) |
| ・ベースプレート温度
Baseplate Temperature | : 25°C | ・使用ヒューズ (F1)
Additional Fuse | : 30A |
| ・ブリッジダイオード
Bridge Rectifier | : PGH758A | ・電解コンデンサ (C1)
Electrolytic Cap. | : 400V 8000uF |
| ・電解コンデンサ (C2)
Electrolytic Cap. | : 100V 100uF | ・セラミックコンデンサ (C3)
Ceramic Cap. | : 50V 22uFx4parallel |
| ・風速
Air Velocity | : 2m/s | | |

(2) 試験結果 (Test Results)

No.	試験箇所 Test Point		試験 モード Test Mode	試験結果 Test Results																		
	部品 Location No.	試験 端子 Test Terminal		Ft:Fire Da:Damaged	So:Smoke Fu:Fuse Blown	Bu:Burst NO:No Output	Se:Smell NC:No Change	Re:Red Hot Ot:Others	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	備考 Note	
				S H O R T	O P E N	発 火	発 煙	破 裂	異 臭	発 熱	破 損	ヒ ュ ー ズ 断 Fu	O V C P P	O C P P	出 力 断 NO	変 化 な し NC	他 Ot					
1	Q101	G		●							●					●				Da: Q102, Q103, Q18, Q19		
2		S		●							●					●				Da: Q102, Q103, Q18, Q19, L2		
3		D		●							●					●				Da: Q102, Q103, Q18, Q19, L2		
4		D-S		●							●					●				Da: Q102, Q103, Q104, Q105		
5		G-S		●							●					●				Da: A1, A2, A3, A4, Q18, Q19, L2		
6		D-G		●							●					●				Da: Q102, Q103, Q1, Q2, A1, A3, R1, R2, R4, R107~R112		
7	Q103	G		●							●					●				Da: Q101, Q102, Q2, A1, A2, A3, A4, Q18, Q19, L2, R1		
8		S		●							●					●				Da: Q18, Q19, L2		
9		D		●							●					●				Da: Q18, Q19, L2		
10		D-S		●							●					●				Da: Q101, Q102, Q2, A1, A2, A3		
11		G-S		●							●					●				Da: Q18, Q19, L2		
12		D-G		●							●					●				Da: Q101, Q102, Q105, Q2, A1, A2, R1		
13	Q104	G		●												●						
14		S		●							●					●				Da: Q101, Q102, Q2, A1, R1		
15		D		●							●					●				Da: Q101, Q102, Q2, A1, R1		
16		D-S		●							●					●				Da: Q101, Q102, Q2, A1, R1		
17		G-S		●							●					●				Da: Q105, A3, R9		
18		D-G		●							●					●				Da: A3		

No.	試験箇所 Test Point	試験 モード Test Mode	試験結果 Test Results													
			Fi:Fire Da:Damaged			So:Smoke Fu:Fuse Blown			Bu:Burst NO:No Output			Se:Smell NC:No Change				
	部品 Location No.	試験 端子 Test Terminal	S H O R T	O P E N T	1 発 火 Fi	2 発 煙 So	3 破 裂 Bu	4 異 臭 Se	5 発 熱 Re	6 破 損 Da	7 ヒ ュ ズ 断 Fu	8 O V P	9 O C P	10 出 力 断 NO	11 変 化 な し NC	12 その 他 Ot
19			E	●									●			
20			C	●									●			
21			B	●									●			
22			B-E	●										●	効率低下 Efficiency Down	
23			C-E	●									●		Da:Q101,Q102,Q103,Q18,Q19	
24			B-C	●									●		Da:Q101,Q102,Q103,Q18,Q19	
25	Q2	E	●										●		Da:Q101,Q102,Q103,Q18,Q19	
26		C	●										●		Da:Q101,Q102,Q103,Q18,Q19	
27		B	●										●		Da:Q101,Q102,Q103,Q18,Q19	
28		B-E	●											●	効率低下 Efficiency Down	
29		C-E	●										●			
30		B-C	●										●			
31	Q3	G	●						●				●		Da:Q101,Q102,Q103,Q18,Q19	
32		S	●						●				●		Da:Q101,Q102,Q103,Q18,Q19	
33		D	●						●				●		Da:Q101,Q102,Q103,Q18,Q19	
34		D-S	●											●	効率低下 Efficiency Down	
35		G-S	●										●			
36		D-G	●						●				●		Da:Q101,Q102,Q103,Q18,Q19	
37	Q201	E	●										●			
38		C	●										●			
39		B	●										●			
40		B-E	●										●			
41		C-E	●										●			
42		B-C	●										●			
43	Q202	E	●							●						
44		C	●										●			
45		B	●							●						
46		B-E	●										●			
47		C-E	●							●			●		Da:A201	
48		B-C	●							●			●		Da:Z202	
49	D104	A-K	●											●	効率低下 Efficiency Down	
50		A-K	●							●			●		Da:Q104	
51	A1	1	●										●			
52		2	●										●			
53		3	●										●			
54		4	●						●						Da:Q101,Q102,Q103	
55		5	●													
56		6	●											●	効率低下 Efficiency Down	
57		7	●						●				●		Da:Q101,Q102,Q103	
58		8	●											●	効率低下 Efficiency Down	
59		1-2	●							●			●		Da:Q101,Q102,Q103,Q2,Q18,Q19,A2,A3,L2,R113,R107~R112	
60		2-3	●							●			●		Da:Q101,Q102,Q104,Q105,Q2,R1	
61		3-4	●										●			
62		5-6	●										●			
63		6-7	●											●	効率低下 Efficiency Down	
64		7-8	●										●			

No.	試験箇所 Test Point		試験モード Test Mode	試験結果 Test Results													
				Fi:Fire Da:Damaged			So:Smoke Fu:Fuse Blown			Bu:Burst NO:No Output			Se:Smell NC:No Change			Re:Red Hot Ot:Others	
	部品 Location No.	試験 端子 Test Terminal	S H R T	O P N E	1 発 火 Fi	2 発 煙 So	3 破 裂 Bu	4 異 臭 Se	5 発 熱 Re	6 破 損 Da	7 ヒ ュ ズ Fu	8 O V P	9 O C P	10 出 力 断 NO	11 変 化 な し NC	12 その 他 Ot	備考 Note
65				●										●			
66	A2	1	●														Da:Q105 出力電圧低下 Output Voltage Down 出力電圧低下 Output Voltage Down
67		2	●							●					●		
68		3	●													●	
69		4	●													●	
70		5	●												●		
71		1-2	●												●		
72		2-3	●							●					●		
73		4-5	●												●		
74	L104			●											●		
75				●											●		Da:Q101,Q102,Q103
76	L1			●											●		Da:Q19,R53
77		1	●							●					●		Da:Q105,A3,R9
78	T101	7	●							●					●		Da:Q104,A2,R8
79		9	●														●出力電圧低下 Output Voltage Down
80		10	●														●出力電圧低下 Output Voltage Down
81		1-2	●												●		
82		7-8	●												●		
83		9-11	●												●		
84	T1	1,3	●												●		
85		7,8	●												●		
86		1-3	●												●		
87		7-8	●												●		
88	入力逆接続									●					●		Da:Q101,Q102,Q103

5. 振動試験 Vibration Test

MODEL : PAH450S48-28

(1) 振動試験種類 Vibration Test Class

掃引振動数耐久試験 Frequency Variable Endurance Test

(2) 使用振動試験装置 Equipment Used

EMIC (株)製 EMIC CORP.	制御部 Controller	F-400-BM-DCS-7800	加振部 Vibrator	905-FN
-------------------------	-------------------	-------------------	-----------------	--------

(3) 供試品台数 The Number of D.U.T. (Device Under Test)

1 台 (unit)

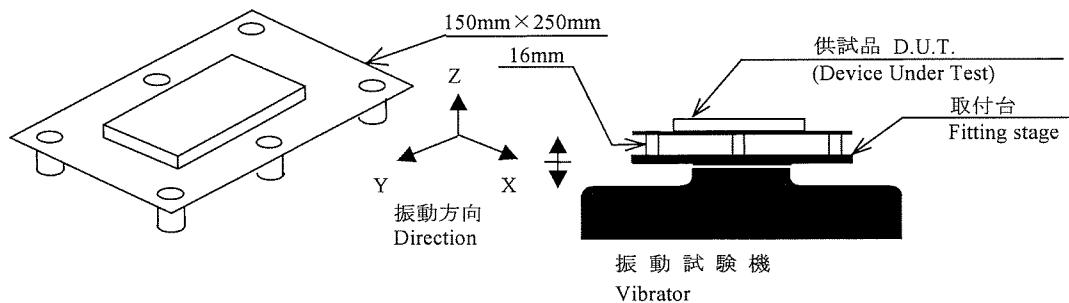
(4) 試験条件 Test Conditions

- ・周波数範囲 : 10～55Hz
Sweep Frequency
- ・掃引時間 : 1 分間
Sweep Time 1 min.
- ・振幅 : 一定 (0.825mm)
Amplitude const.
- ・振幅方向 : X, Y, Z
Directions
- ・試験時間 : 1 時間
Test Time 1 hour each

(5) 試験方法 Test Method

供試品を基板に取付け(M3 ビスで4箇所固定)、それを取付台に固定する。

Fix the D.U.T. on the circuit board (fitting by four M3-tapped-holes) and fit it on the fitting-stage.



(6) 試験結果 Test Results

合格 OK

・試験条件 Test Conditions

入力電圧 : 48VDC

出力電流 : 16A(100%)

ベースプレート温度 : 25°C

Input Voltage

Output Current

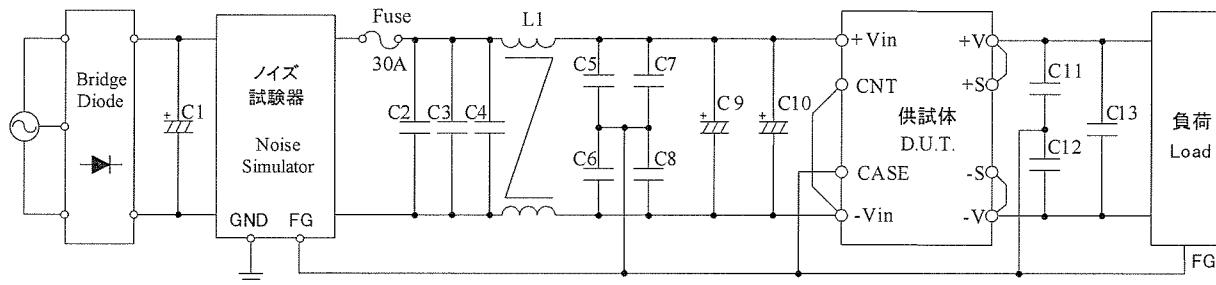
Baseplate Temperature

測定確認項目 Check Item		出力電圧 (V) Output Voltage	リップル電圧 Ripple Voltage	機構・実装状態 D.U.T. State
試験前 Before Test		27.964	67.0	_____
試験後 After Test	X	27.964	68.0	異常無し OK
	Y	27.966	63.5	異常無し OK
	Z	27.973	62.5	異常無し OK

6. ノイズシミュレート試験 Noise Simulate Test

MODEL : PAH450S48-*

(1) 試験回路及び測定器 Test Circuit and Equipment



- ・シミュレーター : INS-4320 (ノイズ研究所)
Simulator (Noise Laboratory Co., LTD.)
- ・ブリッジダイオード(D1) : PGH758A(日本インター)
Bridge Rectifier (NIHON INTER)
- ・電解コンデンサ (C1) : 250V 15000μF
Electrolytic Cap.
- ・セラミックコンデンサ (C2-C4) : 100V 2.2μF
Ceramic Cap.
- ・フィルムコンデンサ (C5,C6) : 275VAC 0.22μF
Film Cap.
- ・フィルムコンデンサ (C7,C8) : 275VAC 4700pF
Film Cap.
- ・電解コンデンサ (C9,C10) : 100V 220μF
Electrolytic Cap.
- ・フィルムコンデンサ (C11,C12) : 250VAC 0.47μF
Film Cap.
- ・セラミックコンデンサ (C13) : 28V : 22μF×4parallel
Ceramic Cap. 48V : 4.7μF×6parallel
- ・チョークコイル (L1) : 80μH
Choke coil

(2) 試験条件 Test Conditions

- | | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|------------------------------|
| ・入力電圧
Input Voltage | : 48VDC | ・ノイズ電圧
Noise Level | : 0V ~ 2kV |
| ・出力電圧
Output Voltage | : 定格
Rated | ・極性
Polarity | : +, - |
| ・出力電流
Output Current | : 28V 16A(100%)
48V 9.4A(100%) | ・印加モード
Mode | : ノーマル、コモン
Normal, Common |
| ・ベースプレート温度
Baseplate Temperature | : 25°C | ・トリガ選択
Trigger Select | : 20Hz ~ 62.5Hz |
| ・パルス幅
Pulse Width | : 50ns~1000ns | | |

(3) 供試品台数 The Number of D.U.T. (Device Under Test)

PAH450S48-28 1台 (unit) PAH450S48-48 1台 (unit)

(4) 判定条件 Acceptable Conditions

- | | | | |
|--------------|---------------------|-------------|------------------------|
| 1.破壊しない事 | Not to be damaged | 3.その他異常のない事 | No other abnormalities |
| 2.出力がダウンしない事 | No output shut down | | |

(5) 試験結果 Test Result

PAH450S48-28	合格 OK
PAH450S48-48	合格 OK

7. はんだ耐熱性試験 Resistance to Soldering Heat Test

MODEL : PAH450S48-28

(1) 使用装置 Machine Used

自動半田付け装置 : TLC-350IV (東京生産技研)
 Automatic Dip Soldering Machine (TOKYO SEISAN GIKEN)

(2) 供試品台数 The Number of D.U.T. (Device Under Test)

1 台 (unit)

(3) 試験条件 Test Conditions

- ・溶融はんだ温度 : 260°C
 Dip Soldering Temperature
- ・浸漬保持時間 : 10秒
 Dip Time 10 seconds
- ・予備加熱温度 : 130°C
 Pre-heating Temperature
- ・予備加熱時間 : 60秒
 Pre-heating Time 60 seconds

(4) 試験方法 Test Method

初期測定の後、供試品を基板にのせ、自動はんだ付装置でフラックス浸漬、予備加熱、はんだ付を行う。常温常湿下に1時間放置し、出力に異常がない事を確認する。

Check if there is no abnormal output before test. Then fix the D.U.T. on a circuit board, transfer to flux-dipping, preheat and solder in the automatic dip soldering machine. Leave it for 1 hour at the room temperature, then check if there is no abnormal output.

(5) 試験結果 Test Results

合格 OK

・試験条件 Test Conditions

入力電圧 : 48VDC Input Voltage	出力電流 : 16A(100%) Output Current	ベースプレート温度 : 25°C Baseplate Temperature
-------------------------------	------------------------------------	---

測定確認項目 Check Item		試験前 Before Test	試験後 After Test
出力電圧 Output Voltage	V	27.976	27.975
リップル電圧 Ripple Voltage	mVp-p	63.5	64.5
入力変動 Line Regulation	mV	11.6	8.3
負荷変動 Load Regulation	mV	11.9	8.9
絶縁抵抗 Isolation Resistance	—	異常なし OK	異常なし OK
耐電圧 Withstand Voltage	—	異常なし OK	異常なし OK
外観 Appearance	—	異常なし OK	異常なし OK

8. 热衝撃試験 Thermal Shock Test

MODEL : PAH450S48-28

(1) 使用計測器 Equipment Used

THERMAL SHOCK CHAMBER TSV-40 (TABAI ESPEC CORP.)

(2) 供試品台数 The Number of D.U.T. (Device Under Test)

5 台 (units)

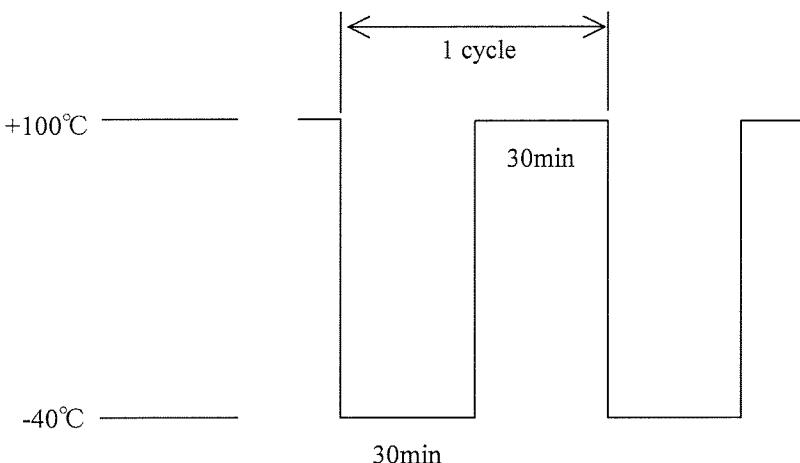
(3) 試験条件 Test Conditions

・電源周囲温度 : -40°C \longleftrightarrow +100°C

Ambient Temperature

・試験時間 : 30min \longleftrightarrow 30min

Test Time



・試験サイクル : 100、200 サイクル

Test Cycles 100, 200 cycles

・非動作

Not Operating

(4) 試験方法 Test Method

初期測定の後、供試品を試験槽に入れ、上記サイクルで試験を行う。100、200 サイクル後に、供試品を常温常湿下に1時間放置し、出力に異常がない事を確認する。

Before the test check if there is no abnormal output and put the D.U.T. in the testing chamber.

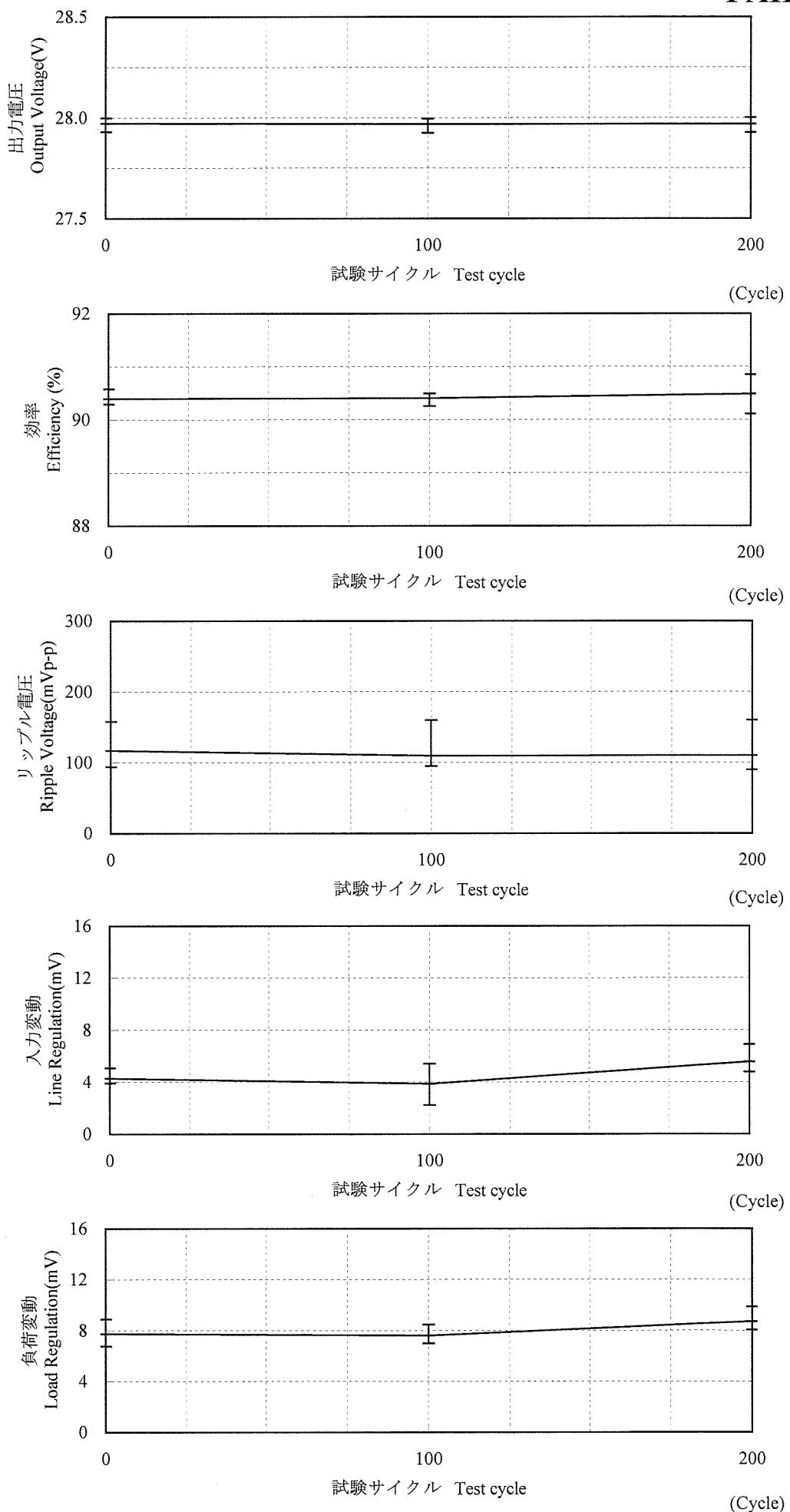
Then test it in the above cycles. After the test is completed leave it for 1 hour at room temperature and check if there is no abnormal output.

(5) 試験結果 Test Results

合格 OK

測定データは、次頁に示す。

See next page for measuring data.



9. 高温貯蔵試験 High Temperature Storage Test

MODEL : PAH450S48-28

(1) 使用計測器 Equipment Used

TEMP.& HUMID. CHAMBER TYPE303D (JEC)

(2) 供試品台数 The Number of D.U.T. (Device Under Test)

1 台 (unit)

(3) 試験条件 Test Conditions

・電源周囲温度 : 100°C
Ambient Temperature

・試験時間 : 100時間
Test Time 100Hours

・非動作
Not operating

(4) 試験方法 Test Method

初期測定の後、供試品を試験槽に入れ、槽の温度を室温（25°C）から規定の温度（100°C）まで徐々に上げる。供試品を規定温度で100時間放置し常温常湿下に1時間放置した後、出力に異常がない事を確認する。

Check if there is no abnormal output before test. Then fix the D.U.T. in testing chamber, and the chamber temperature is gradually increased from 25°C to 100°C. Leave the D.U.T. For 100 hours at 100°C and for 1 hour at the room temperature , then check if there is no abnormal output.

(5) 試験結果 Test Results

合格 OK

・試験条件 Test Conditions

入力電圧 : 48VDC Input Voltage	出力電流 : 16A(100%) Output Current	ベースプレート温度 : 25°C Baseplate Temperature
-------------------------------	------------------------------------	---

測定確認項目 Check Item		試験前 Before Test	試験後 After Test
出力電圧 Output Voltage	V	28.009	28.024
リップル電圧 Ripple Voltage	mVp-p	103.0	114.0
入力変動 Line Regulation	mV	14.3	10.3
負荷変動 Load Regulation	mV	3.0	5.2
絶縁抵抗 Isolation Resistance	—	異常なし OK	異常なし OK
耐電圧 Withstand Voltage	—	異常なし OK	異常なし OK
外観 Appearance	—	異常なし OK	異常なし OK

10. 低温貯蔵試験 Low Temperature Storage Test

MODEL : PAH450S48-28

(1) 使用計測器 Equipment Used

TEMP.& HUMID. CHAMBER PU-4K (ESPEC CORP.)

(2) 供試品台数 The Number of D.U.T. (Device Under Test)

1 台 (unit)

(3) 試験条件 Test Conditions

- | | | | | |
|--------------------------------|---------|--------------------|---------------------|-----------------------|
| ・電源周囲温度
Ambient Temperature | ： -40°C | ・試験時間
Test Time | ： 100時間
100Hours | ・非動作
Not operating |
|--------------------------------|---------|--------------------|---------------------|-----------------------|

(4) 試験方法 Test Method

初期測定の後、供試品を試験槽に入れ、槽の温度を室温（25°C）から規定の温度（-40°C）まで徐々に下げる。供試品を規定温度で100時間放置し常温常湿下に1時間放置した後、出力に異常がない事を確認する。

Check if there is no abnormal output before test. Then fix the D.U.T. in testing chamber, and the chamber temperature is gradually decreased from 25°C to -40°C. Leave the D.U.T. for 100 hours at -40°C and for 1 hour at the room temperature, then check if there is no abnormal output.

(5) 試験結果 Test Results

合格 OK

- | | | | | |
|------------------------|--------------------------|------------------------|-------------|--|
| ・試験条件
Input Voltage | Test Conditions
48VDC | 出力電流
Output Current | ： 16A(100%) | ベースプレート温度
Baseplate Temperature
： 25°C |
|------------------------|--------------------------|------------------------|-------------|--|

測定確認項目 Check Item		試験前 Before Test	試験後 After Test
出力電圧 Output Voltage	V	28.023	27.973
リップル電圧 Ripple Voltage	mVp-p	114.0	110.5
入力変動 Line Regulation	mV	10.3	13.6
負荷変動 Load Regulation	mV	5.2	3.3
絶縁抵抗 Isolation Resistance	—	異常なし OK	異常なし OK
耐電圧 Withstand Voltage	—	異常なし OK	異常なし OK
外観 Appearance	—	異常なし OK	異常なし OK

11. 高温加湿通電試験 High Temperature and High Humidity Bias Test

MODEL : PAH450S48-28

(1) 使用計測器 Equipment Used

TEMP.& HUMID. CHAMBER PSL-2KPH (ESPEC CORP.)

(2) 供試品台数 The Number of D.U.T. (Device Under Test)

3 台 (unit)

(3) 試験条件 Test Conditions

・電源周囲温度 Ambient Temperature	: 85°C	・湿度 Humidity	: 85%RH	・試験時間 Test Time	: 500時間 500Hours
・入力電圧 Input Voltage	: 48VDC	・出力電圧 Output Voltage	: 定格 Rated	・出力電流 Output Current	: 0A(0%)

(4) 試験方法 Test Method

初期測定の後、供試品を試験槽に入れ、槽の温度を室温（25°C）から周囲温度が規定の温度（85°C）になるまで徐々に上げる。供試品を規定の条件にて500時間動作させ、常温常湿下に1時間放置した後、出力に異常がない事を確認する。

Check if there is no abnormal output before test. Then fix the D.U.T. in testing chamber, and the chamber temperature is gradually increased from 25°C to 85°C. Operate the D.U.T. for 500 hours according to above conditions and leave D.U.T for 1 hour at the room temperature, then check if there is no abnormal output.

(5) 試験結果 Test Results

合格 OK

・試験条件 Test Conditions	出力電流 : 16A(100%)			ベースプレート温度 : 25°C	
入力電圧 Input Voltage	Output Current	ベースプレート温度 Baseplate Temperature			

測定確認項目 Check Item	V	No.1		No.2		No.3	
		試験前 Before Test	試験後 After Test	試験前 Before Test	試験後 After Test	試験前 Before Test	試験後 After Test
出力電圧 Output Voltage	V	27.940	27.938	27.952	27.949	27.917	27.910
リップル電圧 Ripple Voltage	mVp-p	156.0	116.0	114.0	113.0	83.0	79.0
入力変動 Line Regulation	mV	4.6	4.5	4.9	4.5	5.9	5.2
負荷変動 Load Regulation	mV	7.3	7.7	6.6	7.6	9.5	10.5
絶縁抵抗 Isolation Resistance	—	異常なし OK	異常なし OK	異常なし OK	異常なし OK	異常なし OK	異常なし OK
耐電圧 Withstand Voltage	—	異常なし OK	異常なし OK	異常なし OK	異常なし OK	異常なし OK	異常なし OK
外観 Appearance	—	異常なし OK	異常なし OK	異常なし OK	異常なし OK	異常なし OK	異常なし OK

12. 高温連続通電試験 High Temperature Bias Test

MODEL : PAH450S48-28

(1) 使用計測器 Equipment Used

TEMP.& HUMID. CHAMBER SH-240SI (ESPEC CORP.)

(2) 供試品台数 The Number of D.U.T. (Device Under Test)

1 台 (unit)

(3) 試験条件 Test Conditions

・ベースプレート温度 Baseplate Temperature	: 100°C	・試験時間 Test Time	: 500時間 500Hours
・入力電圧 Input Voltage	: 76VDC	・出力電圧 Output Voltage	: 定格 Rated

・出力電流 Output Current	: 16A(100%)
-------------------------	-------------

(4) 試験方法 Test Method

初期測定の後、供試品を規定の条件にて500時間動作させ、常温常湿下に1時間放置した後、出力に異常がない事を確認する。

Check if there is no abnormal output before test. Operate the D.U.T. for 500 hours according to above conditions and leave D.U.T for 1 hour at the room temperature, then check if there is no abnormal output.

(5) 試験結果 Test Results

合格 OK

・試験条件 Test Conditions			
入力電圧 Input Voltage	: 48VDC	出力電流 Output Current	: 16A(100%)

ベースプレート温度 : 25°C
Baseplate Temperature

測定確認項目 Check Item		試験前 Before Test	試験後 After Test
出力電圧 Output Voltage	V	28.068	28.045
リップル電圧 Ripple Voltage	mVp-p	185.0	179.0
入力変動 Line Regulation	mV	4.9	5.4
負荷変動 Load Regulation	mV	4.2	3.8
絶縁抵抗 Isolation Resistance	—	異常なし OK	異常なし OK
耐電圧 Withstand Voltage	—	異常なし OK	異常なし OK
外観 Appearance	—	異常なし OK	異常なし OK